


	<h2 style="color: #E67E22;">TK30E06N1,S1X</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">TK30E06N1,S1X</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 60V 43A TO-220
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">TK30E06N1,S1X.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		





### Spezifikationen

Teilenummer	TK30E06N1,S1X
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 43A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 200µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Serie	U-MOSVIII-H
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	53W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1050pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	43A (Ta)

TK30E06N1,S1X Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK30E06N1,S1X-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK30E06N1,S1X Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TK30E06N1,S1X E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>TK30E06N1S1X</b> TOSHIBA TOSHIBA TO-220</p>	 <p><b>TK30S06K3L(T6L1,NQ)</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 60V 30A DPAK-3</p>	 <p><b>TK30A06J3A(STA4,Q)</b> TOS TK30A06J3A(STA4,Q) TOS</p>	 <p><b>TK30S06K3L</b> T TK30S06K3L T</p>
 <p><b>TK30E06N1S1X(S)</b> TOS TOS TO-220</p>	 <p><b>TK30A06N1</b> TOSHIBA TK30A06N1 TOSHIBA</p>	 <p><b>TK30A06N1,S4X(S)</b> TOSHIBA TK30A06N1,S4X(S) TOSHIBA</p>	 <p><b>TK30E06N1</b> TOSHIBA TK30E06N1 TOSHIBA</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TK30E06N1,S1X Toshiba Semiconductor and Storage	TK30E06N1,S1X Datenblatt	TK30E06N1,S1X-Datenblätter	TK30E06N1,S1X PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TK30E06N1,S1X
TK30E06N1,S1X Electronic	TK30E06N1,S1X-Komponenten	TK30E06N1,S1X-Verteiler	TK30E06N1,S1X-Bild	TK30E06N1,S1X-Teil
TK30E06N1,S1X Preis	TK30E06N1,S1X Hersteller	TK30E06N1,S1X Bild	TK30E06N1,S1X Aktie	TK30E06N1,S1X Inventar
TK30E06N1,S1X Neu	TK30E06N1,S1X Original	TK30E06N1,S1X garantiert	TK30E06N1,S1X RFQ	TK30E06N1,S1X Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited